

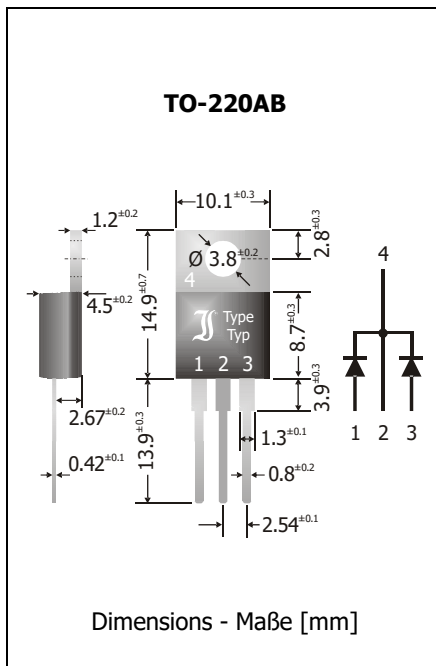
**30CTQ200**

**High Temperature Schottky Rectifier Diodes**  
**Hochtemperatur-Schottky-Gleichrichterdiodes**

$I_{FAV} = 2 \times 15 \text{ A}$   
 $V_{F1} \sim 0.72 \text{ V}$   
 $T_{jmax} = 175^\circ\text{C}$

$V_{RRM} = 200 \text{ V}$   
 $I_{FSM} = 225/250 \text{ A}$

Version 2017-09-18

**Typical Applications**

High Frequent Output Rectification in DC/DC Converters, Polarity Protection, Free-wheeling diodes Commercial grade <sup>1)</sup>

**Typische Anwendungen**

Hochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung in Gleichstromwandlern, Verpolschutz, Freilaufdiodes Standardausführung <sup>1)</sup>

**Features**

High temperature operation  
 High reverse voltage  
 Dual diodes with common cathode  
 Low forward voltage drop  
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Hochtemperatur-Einsatz  
 Hohe Sperrspannung  
 Doppeldioden mit gemeinsamer Kathode  
 Niedrige Fluss-Spannung  
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Packed in tubes/cardboards 50/1000  
 Weight approx. 2.2 g  
 Case material UL 94V-0  
 Solder & assembly conditions 260°C/10s  
 MSL = 1

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Verpackt in Stangen/Kartons  
 Gewicht ca. Gehäusematerial  
 Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>3)</sup>**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
30CTQ200	200	200

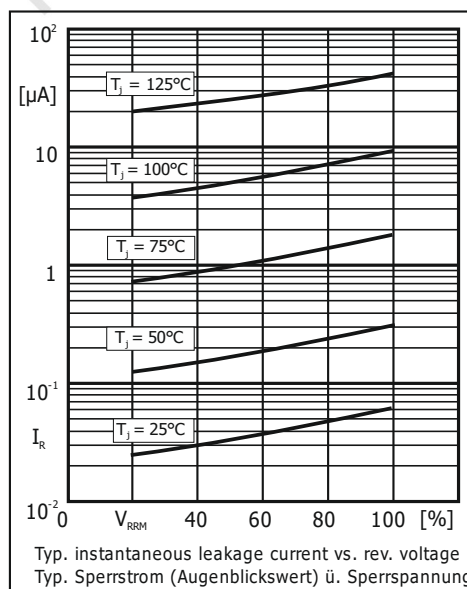
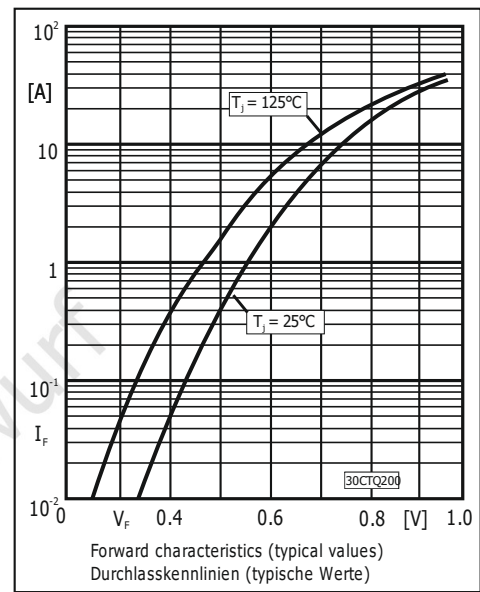
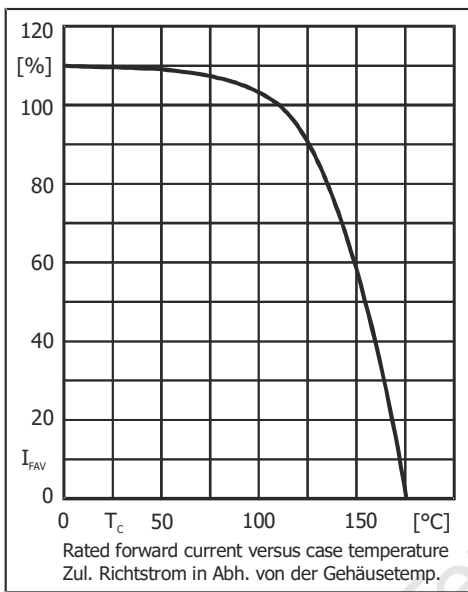
Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung	$T_C = 110^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	15 A <sup>3)</sup> 30 A <sup>4)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$T_C = 110^\circ\text{C}$	$I_{FRM}$ 53 A <sup>3)</sup>
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	$I_{FSM}$ 225 A 250 A
Rating for fusing Grenzlastintegral	$t < 10 \text{ ms}$	$i^2t$	80 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_j$	-50...+175°C -50...+150°C

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$  wenn nicht anders angegeben
- Per diode – Pro Diode
- Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)

**Characteristics <sup>1)</sup>**

**Kennwerte <sup>1)</sup>**

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	V <sub>F</sub> [V]	@ I <sub>F</sub> [A]	@ T <sub>j</sub>	V <sub>F</sub> [V]	@ I <sub>F</sub> [A]	@ T <sub>j</sub>
30CTQ200	typ 0.72	15	125°C	< 0.86	15	25°C
Leakage current Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C T <sub>j</sub> = 125°C			V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	I <sub>R</sub>	< 50 μA typ. 1 mA
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität				V <sub>R</sub> = 4 V	C <sub>j</sub>	220 pF
Thermal resistance junction to case – Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse					R <sub>thc</sub>	< 3 K/W <sup>2)</sup>



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Per diode – Pro Diode  
2 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne